

600V半桥栅极驱动芯片

描述

FG2601是一款针对于双NMOS的半桥栅极驱动芯片，专为高压、高速驱动N型功率MOSFET和IGBT设计，可在高达600V电压下工作。

FG2601内置VCC和VBS欠压(UVLO)保护功能，防止功率管在过低的电压下工作，提高效率。

FG2601输入脚兼容3.3-15.0V输入逻辑，上下管延时匹配最大为50ns，驱动能力为+0.3A/-0.6A。

FG2601采用SOP8封装。

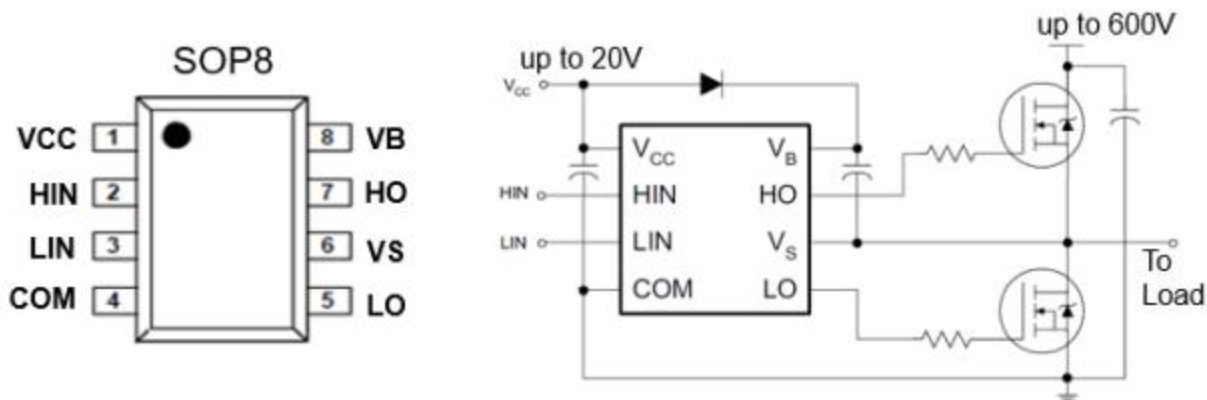
特性

- 悬浮绝对电压600V
- 电源电压工作范围:10.0-20.0V
- 兼容3.3/5/15V输入逻辑
- 驱动电流:+0.3A/-0.6A(typ.)
- 延时匹配时间:50ns
- 集成VCC和VBS欠压保护
- SOP8封装

典型应用

- 马达驱动
- 逆变器电源
- LLC电源

FG2601封装和简单应用电路图

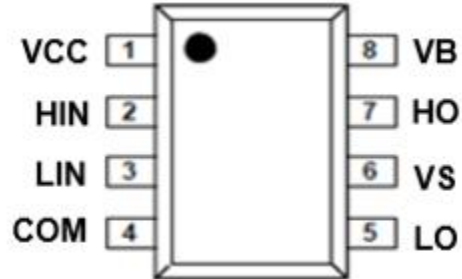


订购信息

型号	封装	数量	工作温度
FG2601	SOP8	4000	-40~125 °C

600V半桥栅极驱动芯片

脚位定义



管脚号	管脚名称	类型	管脚描述
1	VCC	P	电源供电输入脚
2	HIN	I	高侧输入
3	LIN	I	低侧输入
4	COM	P	地
5	LO	O	低侧输出
6	VS	O	高侧浮动地
7	HO	O	高侧输出脚
8	VB	I	高侧浮动电源

600V半桥栅极驱动芯片
绝对最大定额值($T_A=25^{\circ}\text{C}$)

参数		最小	最大	单位
高侧浮动电源电压	VB	-0.3	700	V
高侧浮动地电压	VS	VB-25	VB+0.3	
高侧输出电压	VHO	VS-0.3	VB+0.3	
低侧电源电压	VCC	-0.3	25	
低侧输出电压	VLO	-0.3	VCC+0.3	
逻辑输入电压	HIN,LIN	-0.3	VCC+0.3	
可允许摆动电压摆率	dVs/dt		50	V/ns
工作温度	T_J	-40	150	$^{\circ}\text{C}$
工作环境温度	T_A	-40	125	
存储温度	T_{stg}	-65	150	
热阻	θ_{JA}		260	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

推荐工作范围($T_A=25^{\circ}\text{C}$)

参数		最小	最大	单位
高侧浮动电源电压	VB	-0.3	600	V
高侧浮动地电压	VS	VB-25	VB+0.3	
高侧输出电压	VHO	VS-0.3	VB+0.3	
低侧电源电压	VCC	10	20	
低侧输出电压	VLO	-0.3	20.0	
逻辑输入电压	HIN,LIN	-0.3	20.0	
工作环境温度	T_A	-40	125	$^{\circ}\text{C}$

600V半桥栅极驱动芯片
电气特性($V_{CC}=V_{BS}=15.0V, C_L=1000pF, T_A=25\text{ }^\circ\text{C}$)

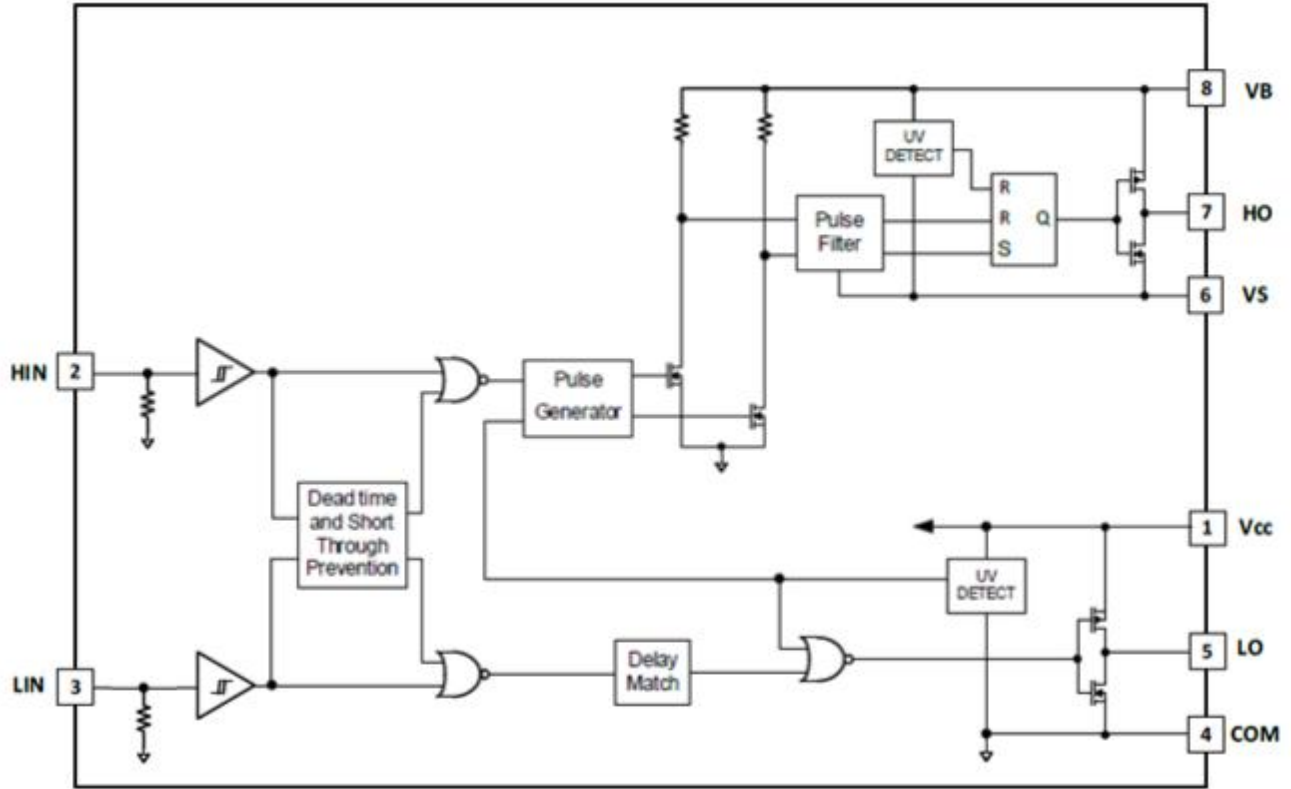
参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电流					
V _{CC} 静态电流	I _{CC_OFF}	HIN,LIN悬空		135	uA
V _{CC} 静态电流	I _{CC_ON}	HIN,LIN为“1”		130	uA
V _B 静态电流	I _{B_ON}			35	uA
漏电电流	I _{LK}	V _B =V _S =600V		0.1	uA
PWM逻辑输入特性					
逻辑高电位	V _{INH}			2.5-	V
逻辑低电位	V _{INL}			00.8	V
下拉电阻	R _{PD}			300	kQ
保护特性					
V _{BSUVLO} 上升保护阈值	V _{BSUV_R}			8.35	V
V _{BSUVLO} 下降保护阈值	V _{BSUV_F}			7.75	V
V _{BSUVLO} 迟滞	V _{BSUV_H}			600	mV
V _{CCUVLO} 上升保护阈值	V _{CCUV_R}			8.45	V
V _{CCUVLO} 下降保护阈值	V _{CCUV_F}			7.85	V
V _{CCUVLO} 迟滞	V _{CCUV_H}			600	mV
输出驱动能力					
低侧/高侧上管输出电压	V _{OHL}	I _O =20mA		320	mV
低侧/高侧下管输出电压	V _{OLL}	I _O =20mA		110	mV
低侧/高侧上管输出峰值电流	I _{OHL}	V _O =0, V _{IN} =5V		0.3	A
低侧/高侧下管吸收峰值电流	I _{OLL}	V _O =15V, V _{IN} =0V		0.6	A

600V半桥栅极驱动芯片
动态电特性($V_{CC}=V_{BS}=15.0V, C_L=1000pF, T_A=25\text{ }^{\circ}C$)

参数		最小值典型值最大值	单位
上管开通延时	T_{ONH}	260	ns
上管关断延时	T_{OFFH}	140	ns
下管开通延时	T_{ONL}	260	ns
下管关断延时	T_{OFFL}	140	ns
死区时间	DT	100	ns
延时匹配时间	MT	050	ns
开通上升时间	T_R	55	ns
关断下降时间	T_F	30	ns

600V半桥栅极驱动芯片

电路框图



600V半桥栅极驱动芯片

应用说明

低侧供电

VCC是低侧电源,它为输入逻辑和低侧输出功率级提供电源。内置欠压锁定电路使器件能够在VCC高于VCCUV+(8.45V)的典型电源电压时,以足够的电源工作,如图1所示。当VCC电源电压低于VCCUV-(7.85V)时,IC关闭栅极驱动器输出,如图1所示。这样可以防止外部功率器件在通电期间处于极低的栅极电压水平,从而防止功耗过高。

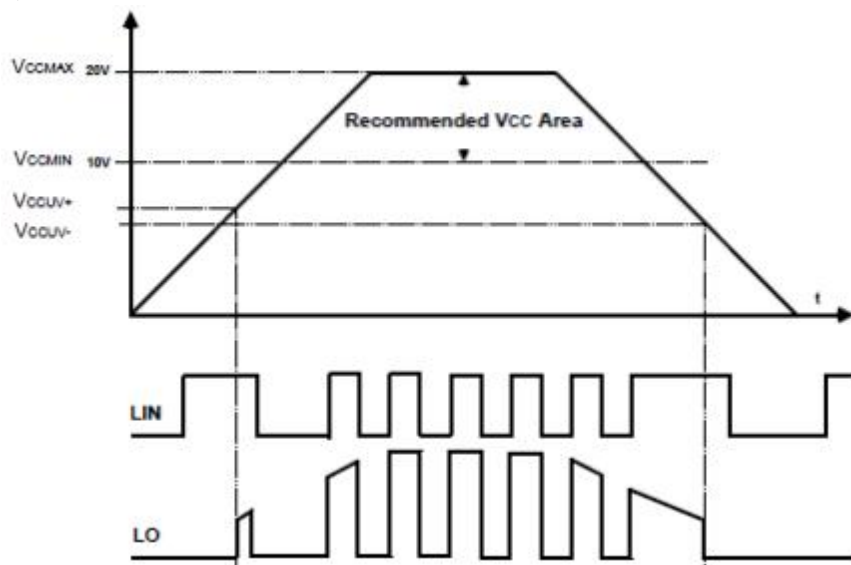


图1: VCCUVLO波形

高侧电源

VB到VS是高侧电源电压。高侧电路可以随外部高侧功率器件的极器/源极电压相对于COM浮动。由于内部功耗低,整个高边电路可通过连接到VCC的靴带式抬压拓扑提供,并且可以通过PINVB和PINVS之间的小型靴带式电容器供电。图2给出了器件作为电源电压的函数的工作区域。

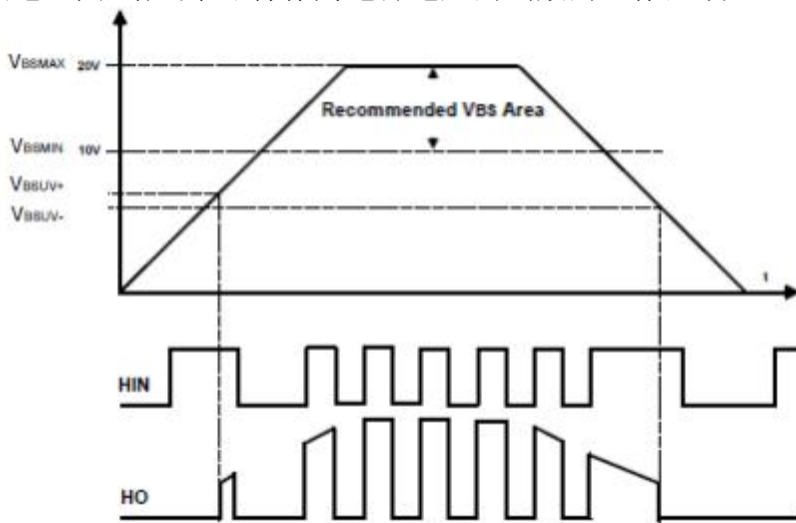
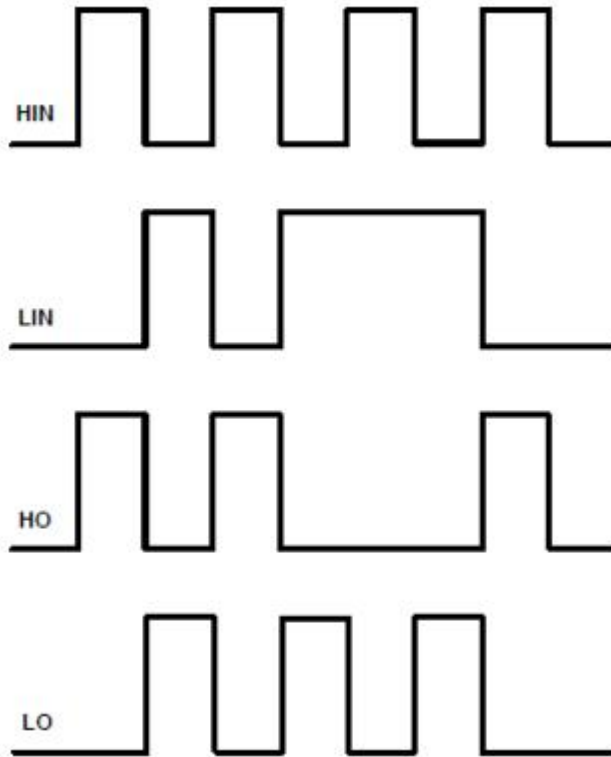


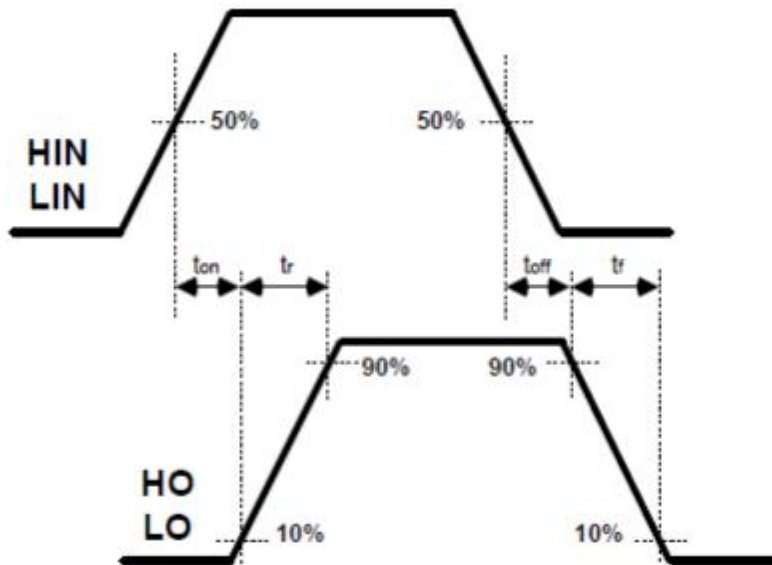
图2: VBSUVLO波形

600V半桥栅极驱动芯片

高低侧输入输出逻辑时序图
输入-输出时序图

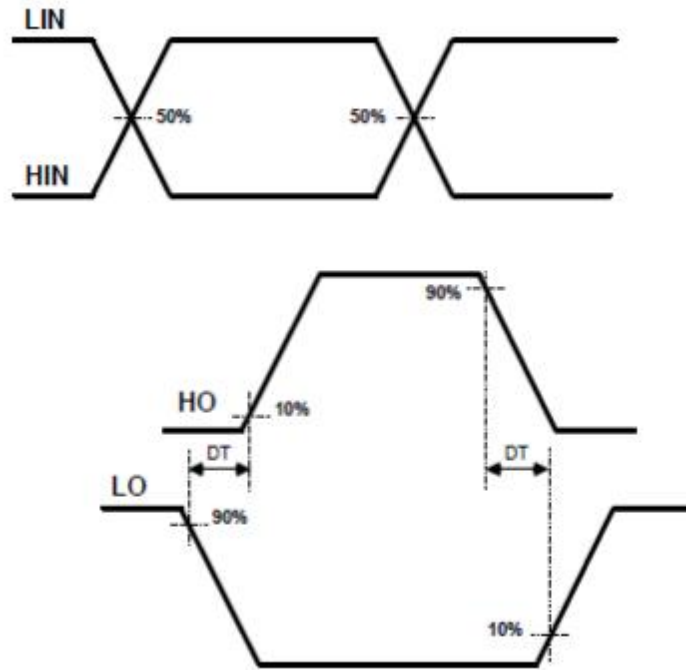


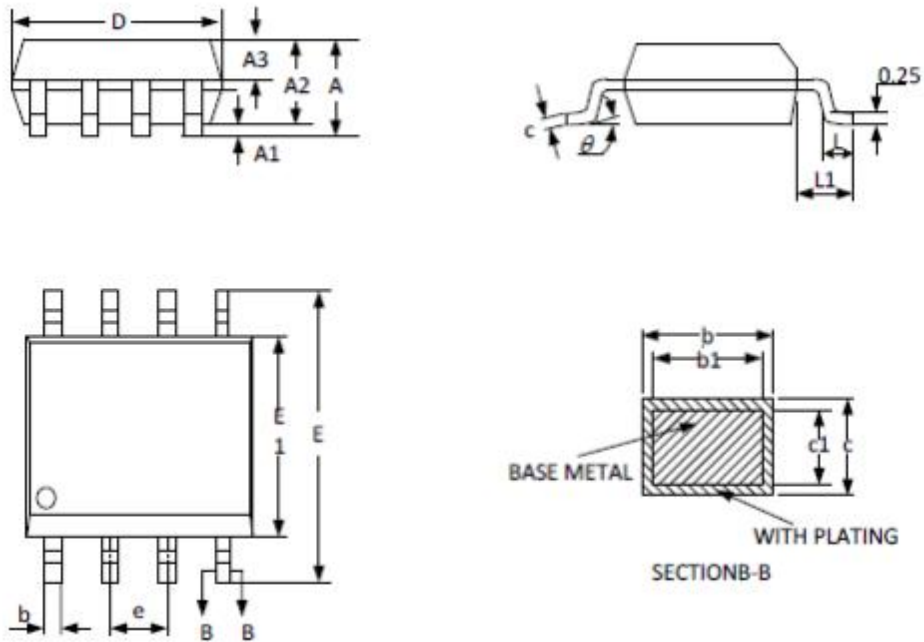
开关时间时序图



600V半桥栅极驱动芯片

死区时间时序图



600V半桥栅极驱动芯片
封装信息
SOP8


SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	--	--	1.77
A1	0.08	0.18	0.28
A2	1.20	1.40	1.60
A3	0.55	0.65	0.75
b	0.39	--	0.48
b1	0.38	0.41	0.43
c	0.21	--	0.26
c1	0.19	0.20	0.21
D	4.70	4.90	5.10
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.70	3.90	4.10
e	1.27BSC		
L	0.50	0.65	0.80
L1	1.05BSC		
θ	0	--	8°

600V半桥栅极驱动芯片

联系方式

深圳市方为半导体有限公司

Shenzhen Fargo-Silicon Semiconductor Co., Ltd.

深圳市南山区高新北六道27号兰光科技大厦A313室

Zip Code : 518000

Tel : +86-755-8666-5695

Sales: sales@fargo-silicon.com

Technical support: support@fargo-silicon.com